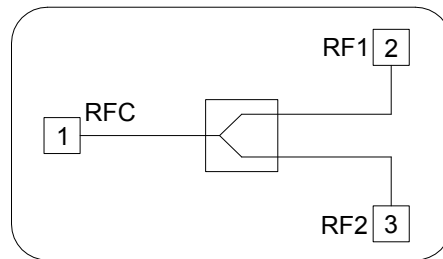


特点:

- 频率: 8~12GHz
- 插入损耗: 0.8dB
- 2路功分器
- 工作温度: -55~+85℃
- 芯片尺寸: 1.3×1.25×0.1mm

功能框图

性能参数: (T_A=+25℃)

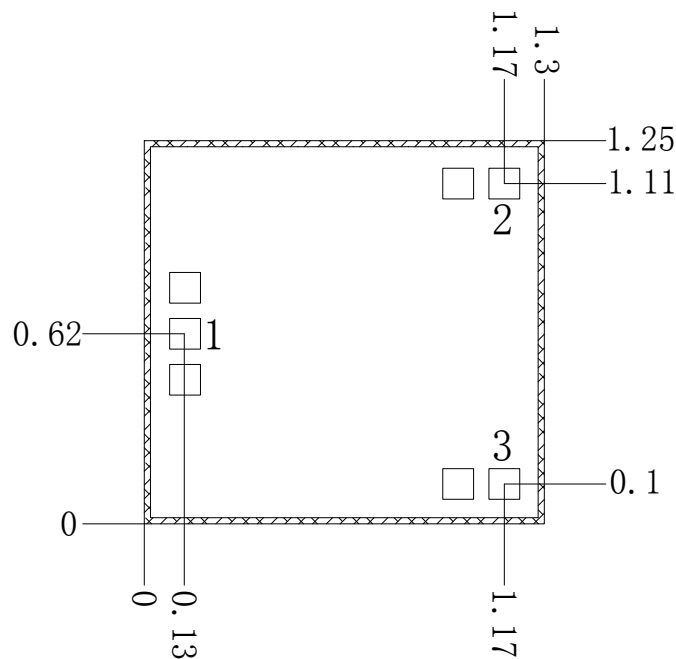
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注	
			MIN	TYP	MAX			
频率范围	f	Z _{in} =Z _{out} =50Ω f=8~12GHz	8		12	GHz		
插入损耗	IL			0.6	1	dB		
幅度不平衡度	AU				0.2	0.3	dB	
隔离度	ISO			31	40		dB	
输入驻波	VSWR _i				1.2	2		
输出驻波	VSWR _o				1.1	2		

极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
最大输入功率	+22	dBm	贮存温度	-55~+150	℃

芯片尺寸图:

单位: mm

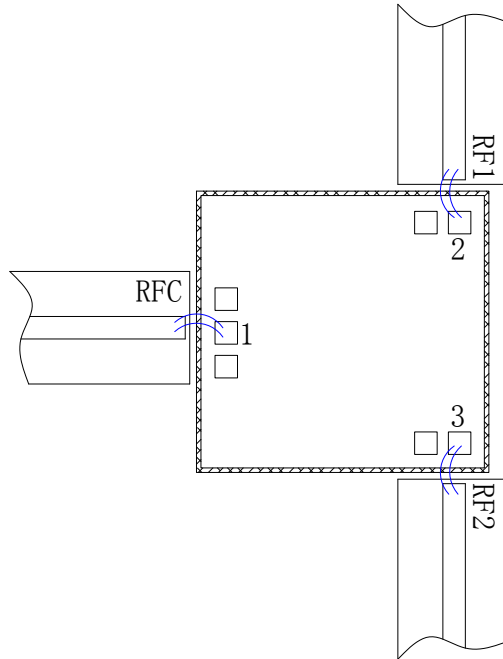


注: 典型键合焊盘尺寸为 100*100um

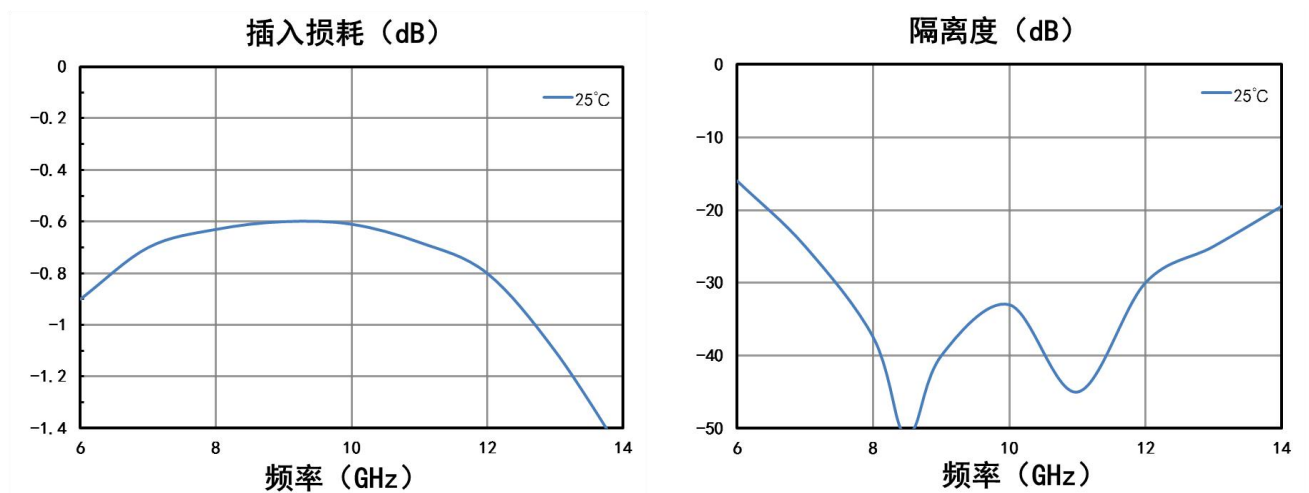
引脚定义:

引脚	定义	描述
1	RFC	射频公共端口, 50Ω
2	RF1	射频支路端口 1, 50Ω
3	RF2	射频支路端口 2, 50Ω
芯片背面	GND	芯片背面必须接至 RF/DC 地

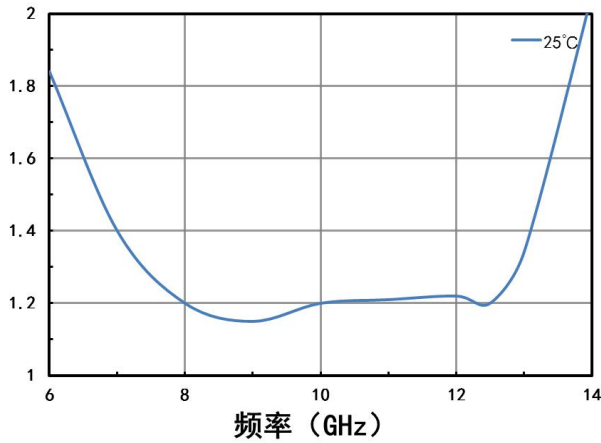
推荐装配图:



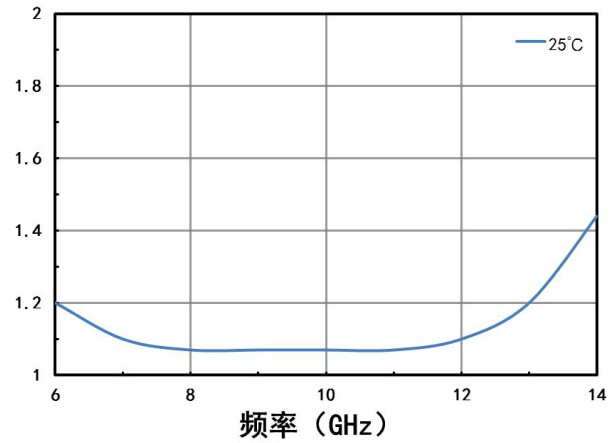
典型测试曲线:



输入驻波比



输出驻波比



产品使用注意事项:

- 1.本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用；
- 2.裸芯片使用的 GaAs 材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面使用时必须小心；
- 3.芯片底部用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 295℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
- 4.芯片微波端口与微带线间歇不超过 3 mil，使用 1 mil 双金丝键合，其他端口使用 1 mil 单金丝，建议金丝长度 10~16 mil；
- 5.产品对静电敏感，在存储和使用过程中注意防静电；
6. 其他使用说明详见《裸芯片产品使用说明》。